

CMPH-3E
CMPH-3AE
CMPH-3CE
CMPH-3SE

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES**



SOT-23 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPH-3E Series types are Enhanced Versions of the CMPH-3 Series of Silicon Schottky Diodes in an SOT-23 Surface Mount Package.

FEATURED ENHANCED SPECIFICATIONS:

- ◆ I_F from 100mA max to 200mA max.
- ◆ BV_R from 30V min to 40V min.
- ◆ V_F from 1.0V max to 0.8V max.

CMPH-3E: SINGLE
CMPH-3AE: DUAL, COMMON ANODE
CMPH-3CE: DUAL, COMMON CATHODE
CMPH-3SE: DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: D95E
MARKING CODE: DB1E
MARKING CODE: DB2E
MARKING CODE: DA5E

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

- ◆ **Peak Repetitive Reverse Voltage**
- ◆ **Continuous Forward Current**
- Peak Repetitive Forward Voltage
- Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$
- Power Dissipation
- Operating and Storage Junction Temperature
- Thermal Resistance

SYMBOL		UNITS
V_{RRM}	40	V
I_F	200	mA
I_{FRM}	350	mA
I_{FSM}	750	mA
P_D	350	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Θ_{JA}	357	$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=25\text{V}$		90	500	nA
I_R	$V_R=25\text{V}, T_A=100^{\circ}\text{C}$		25	100	μA
◆ BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	40	50		V
V_F	$I_F=2.0\text{mA}$		0.29	0.33	V
◆ V_F	$I_F=15\text{mA}$		0.37	0.42	V
◆ V_F	$I_F=100\text{mA}$		0.61	0.80	V
◆ ◆ V_F	$I_F=200\text{mA}$		0.65	1.0	V
C_T	$V_R=1.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		7.0		pF
t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA}, I_{rr}=1.0\text{mA}, R_L=100\Omega$			5.0	ns

◆ Enhanced specification

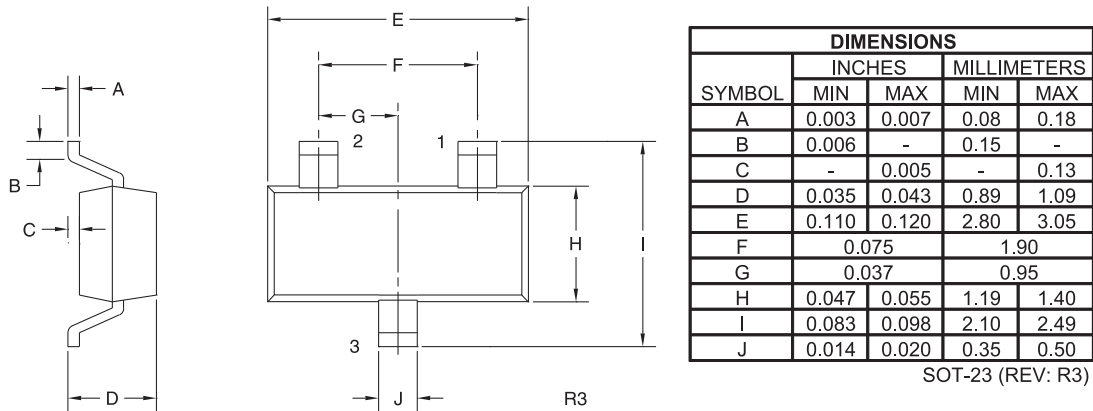
◆ ◆ Additional Enhanced specification

CMPSH-3E
CMPSH-3AE
CMPSH-3CE
CMPSH-3SE

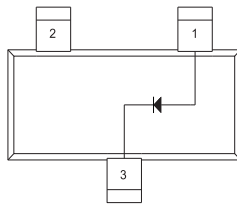
**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES**



SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATIONS

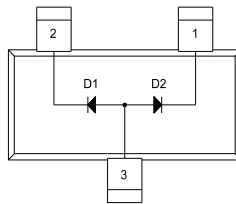


CMPSH-3E

LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

MARKING CODE: D95E

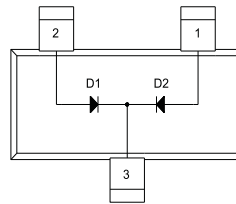


CMPSH-3AE

LEAD CODE:

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, D2

MARKING CODE: DB1E

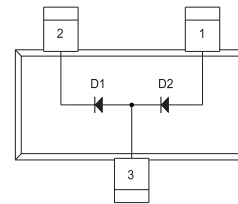


CMPSH-3CE

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Anode D1
- 3) Cathode D1, D2

MARKING CODE: DB2E



CMPSH-3SE

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: DA5E

R3 (27-January 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9